



2SB941 (3CA941)

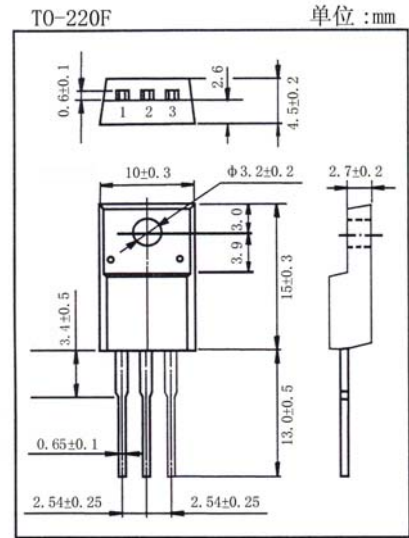
硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于低频功率放大./Purpose: For low-frequency power amplification.

特点:大电流 HFE 曲线特性好、集电-发射极饱和压降小、采用 T0-220 全包封不需云母绝缘可直接安装散热片。/Feature: High forward current transfer ratio Hfe which has satisfactory linearity, low collector to emitter saturation voltage  $V_{CE(sat)}$  Full-pack package which can be installed to the heat sink with one screw

极限参数/Absolute maximum ratings( $T_a=25^{\circ}C$ )

参数符 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CBO}$	-60	V
$V_{CEO}$	-60	V
$V_{EBO}$	-5.0	V
$I_C$	-3.0	A
$I_{CP}$	-5	A
$P_C$	2.0	W
$T_j$	150	$^{\circ}C$
$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}C$



电性能参数/Electrical characteristics( $T_a=25^{\circ}C$ )

引脚: 1. B 2. C 3. E

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CEO}$	$I_C=-30mA$ $I_B=0$	-60			V
$I_{CEO}$	$V_{CE}=-30V$ $I_B=0$			-300	$\mu A$
$I_{CES}$	$V_{CE}=-60V$ $V_{BE}=0$			-200	$\mu A$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5V$ $I_C=0$			-1	mA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-4.0V$ $I_C=-1.0A$	70		250	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-4.0V$ $I_C=-3.0A$	10			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-3.0A$ $I_B=-0.375A$			-1.2	V
$V_{BE}$	$V_{CE}=-4V$ $I_C=-3A$			-1.8	V
$f_T$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-0.5A$ $f=10MHz$		30		MHz
$t_{on}$	$I_C=-1A$ $I_{B1}=-0.1A$ $I_{B2}=0.1A$		0.5		$\mu S$
$t_{stg}$			1.2		$\mu S$
$t_f$			0.3		$\mu S$

$h_{FE(1)}$  分档/ $h_{FE(1)}$  classifications: Q:70~150 P:120~250

